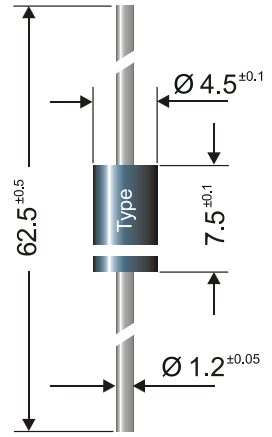
查询BY296供应商

Fast Silicon Rectifiers **Schnelle Silizium Gleichrichter**



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100…800 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ DO-201
Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 16 siehe Seite 16

Maximum ratings **Grenzwerte**

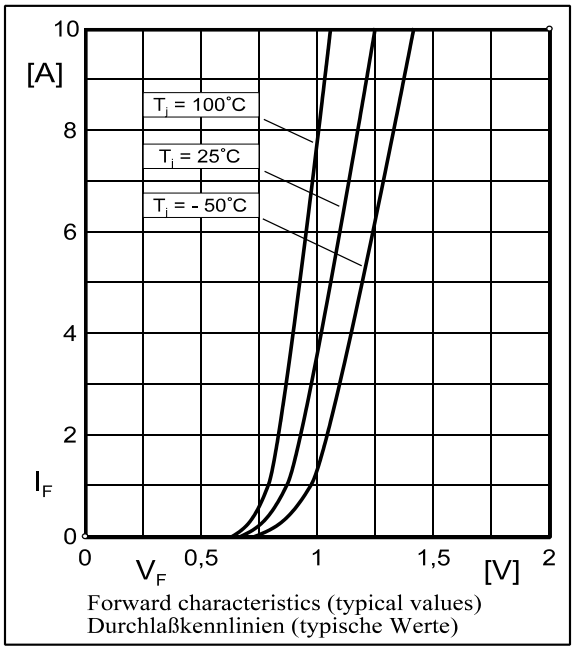
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
BY 296	100	100
BY 297	200	200
BY 298	400	400
BY 299	800	800

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	T_A = 50°C	I_{FAV}	2 A [1])
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f >15 Hz	I_{FRM}	20 A [1])
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25°C	I_{FSM}	70 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	T_A = 25°C	i^2t	24 A^2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	– 50…+150°C – 50…+175°C

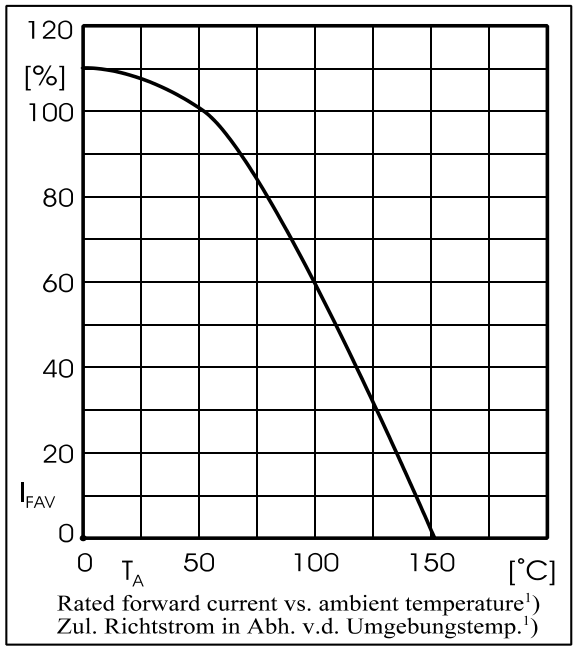
[1]) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics — Kennwerte

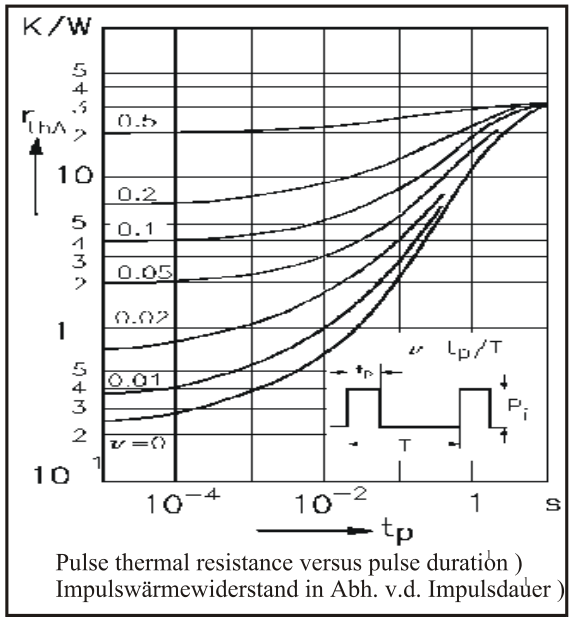
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25°C$	$I_F = 3$ A	V_F	< 1.3 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25°C$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Forward recovery time – Durchlaßverzug		$I_F = 100$ mA	t_{fr}	< 1.0 µs
Reverse recovery time Sperrverzugszeit	$I_F = 0.5$ A through/über $I_R = 1$ A to/auf $I_R = 0.25$ A		t_{rr}	< 500 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 25 K/W [1])



Forward characteristics (typical values)
Durchlaßkennlinien (typische Werte)



Rated forward current vs. ambient temperature[1])
Zul. Richtstrom in Abh. v.d. Umgebungstemp.[1])



Pulse thermal resistance versus pulse duration)
Impulswärmewiderstand in Abh. v.d. Impulsdauer)

[1]) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden